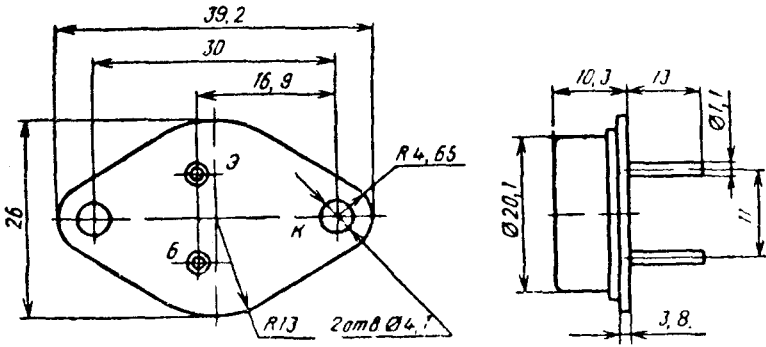


2Т834 (А, Б, В), КТ834 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры $n-p-n$ составные усиленные. Предназначены для применения в регуляторах тока и напряжения, в переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 22 г

2Т834 (А-В) КТ834 (А-В)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 5$ А.

$T_K = +25^\circ\text{C}$

$T_K = T_{K, \text{макс}}$, не менее

$T_K = T_{K, \text{мин}}$, не менее

при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 10$ А, $T_K = +25^\circ\text{C}$

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 5$ А, $f = 1$ МГц

Граничное напряжение при $I_K = 0.1$ А, $L = 25$ мГц

2Т834А, КТ834А

2Т834Б, КТ834Б

2Т834В, КТ834В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 15$ А, $I_B = 1.5$ А

Время спада при $U_{КЭ} = 250$ В, $U_{БЭ} = 5$ В, $I_K = 10$ А, $I_B = 1$ А

Обратный ток коллектор — эмиттер при $R_{бэ} = 100$ Ом

$T_K = +25^\circ\text{C}$, $U_{КЭВ} = U_{КЭВ, \text{макс}}$, не более

типичное значение

$T_K = T_{K, \text{макс}}$, $U_{КЭВ} = U_{КЭВ, \text{и, макс}}$, не более

$T_K = T_{K, \text{мин}}$, $U_{КЭВ} = U_{КЭВ, \text{и, макс}}$, не более

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В, не более

типичное значение

150 500* 3000*

150

50

60.250* 1250*

4* 5* 7,8*

400 450* 490* В

350 375* 440* В

300 340* 375* В

1,2* 1,5* 2 В

0,25* 0,6* 1,2 мкс

3 мА

0,2* мА

3 мА

3 мА

50 мА

25* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер¹ при

$R_{бэ} = 100$ Ом, $T_K = -40...+85^\circ\text{C}$:

2Т834А, КТ834А

2Т834Б, КТ834Б

2Т834В, КТ834В

500 В

450 В

400 В

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при

$R_{бэ} = 100$ Ом, $t_{ф} \geq 0.2$ мкс:

2Т834А, КТ834А

2Т834Б, КТ834Б

2Т834В, КТ834В

400 В

350 В

300 В

Постоянное напряжение база — эмиттер

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 0.5$ мс, $Q \geq 100$

Постоянный ток базы

Импульсный ток базы при $t_u \leq 0.5$ мс, $Q \geq 100$

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора² при

$T_K = T_{K, \text{мин}}$, $+25^\circ\text{C}$

Температура $p-n$ перехода

Температура окружающей среды:

2Т834А—2Т834В

КТ834А—КТ834В

8 В

15 А

20 А

3,5 А

7 А

100 Вт

$+150^\circ\text{C}$

$-60^\circ\text{C}...T_K = +125^\circ\text{C}$

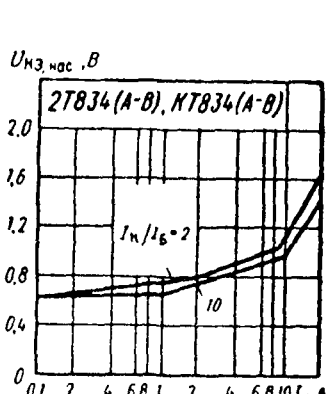
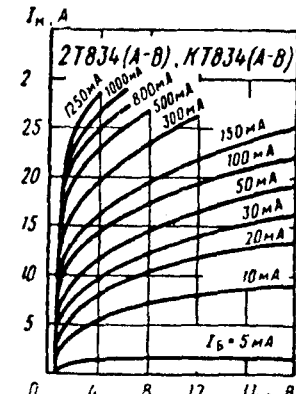
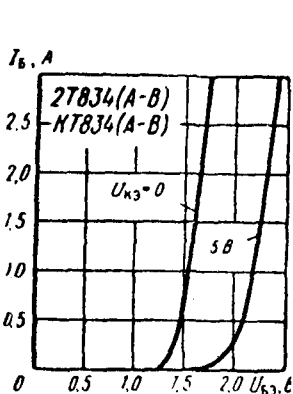
$-40^\circ\text{C}...T_K = +85^\circ\text{C}$

¹ При $T_K = -40...-60^\circ\text{C}$ и $T_K = +85...+125^\circ\text{C}$ $U_{КЭВ, \text{макс}}$ снижаются линейно до 400 В для 2Т834А, КТ834А; 350 В для 2Т834Б, КТ834Б; 300 В для 2Т834В, КТ834В.

² При $T_K > +25^\circ\text{C}$ $P_{К, \text{макс}} = W_T = (T_n - T_K) / R_{T(n-k)}$, где $R_{T(n-k)}$ определяется из области максимальных режимов.

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер практически не зависит от сопротивления в цепи база — эмиттер (до 10 кОм). Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

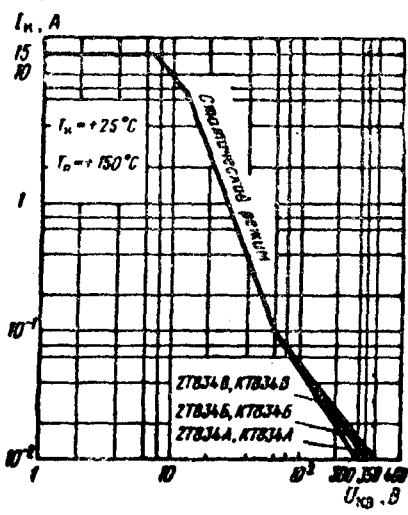
Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса паяльником с температурой не более $+260^\circ\text{C}$ в течение не более 10 с.



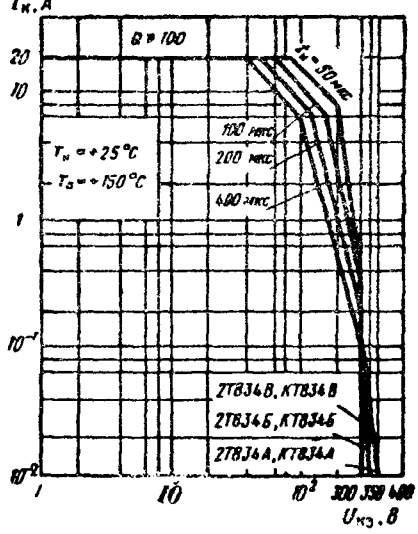
Входные характеристики

Выходные характеристики

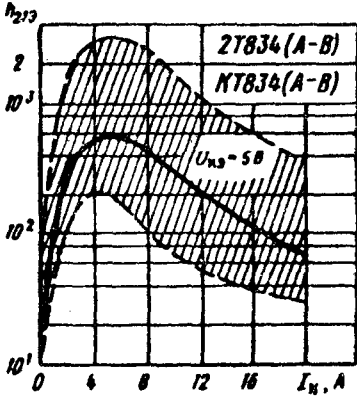
Зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



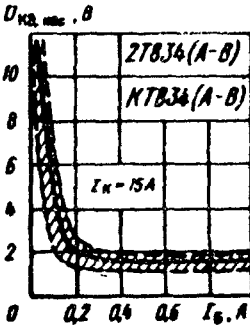
Области максимальных режимов



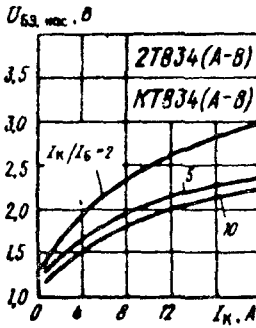
Области максимальных режимов



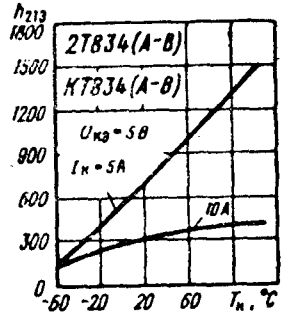
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



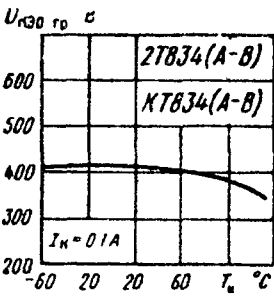
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока базы



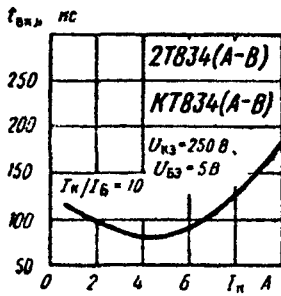
Зависимости напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



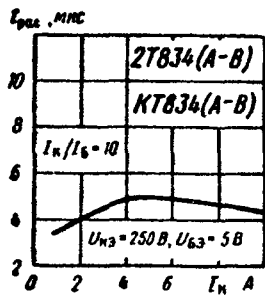
Зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



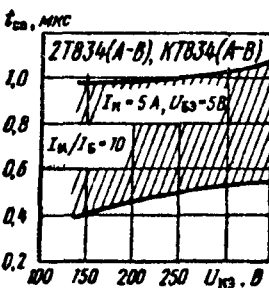
Зависимость граничного напряжения от температуры корпуса



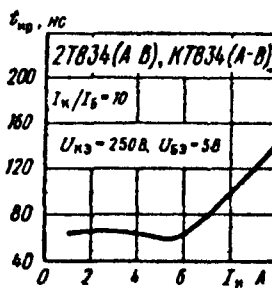
Зависимость времени включения от тока коллектора



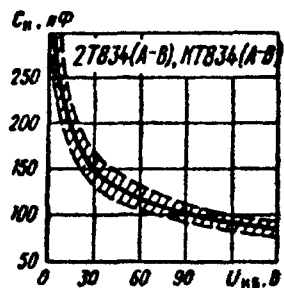
Зависимость времени рассасывания от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости времени спада от напряжения коллектор — эмиттер



Зависимость времени нарастания от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база